

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-017578

(43)Date of publication of application : 17.01.2003

(51)Int.Cl.

H01L 21/8234

H01L 21/265

H01L 27/088

H01L 29/78

(21)Application number : 2001-198594

(71)Applicant : FUJITSU LTD
FUJITSU VLSI LTD

(22)Date of filing : 29.06.2001

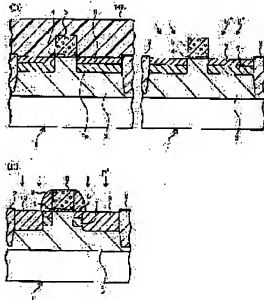
(72)Inventor : WADA HAJIME
OKABE KENICHI
WATANABE KO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device capable of forming a pocket area by using indium and decreasing the increase of leak current by ion injection of indium.

SOLUTION: The semiconductor device has first and second active areas demarcated on the main surface of a silicon substrate, a first n channel MOS transistor formed on the first active area having a first extension area and a first pocket area adding the indium of first concentration at a position deeper than the first extension area, and a second n channel MOS transistor formed on the second active area having a second extension area and a second pocket area adding the indium of second concentration lower than the first concentration at another position deeper than the second extension area. Furthermore, boron may be ion-injected in the second pocket area.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

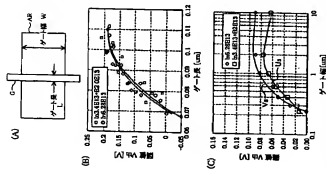
[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



【特許補正2】

【図出日】平成13年12月19日(2001.12.19)

【特許補正1】

【特許補正2】

【特許補正3】

【特許補正4】

【特許補正5】

【特許補正6】

【特許補正7】

【特許補正8】

【特許補正9】

【特許補正10】

【特許補正11】

【特許補正12】

【特許補正13】

【特許補正14】

【特許補正15】

【特許補正16】

【特許補正17】

【特許補正18】

【特許補正19】

【特許補正20】

【特許補正21】

【特許補正22】

【特許補正23】

【特許補正24】

【特許補正25】

【特許補正26】

【特許補正27】

【特許補正28】

【特許補正1】

【特許補正2】

【特許補正3】

【特許補正4】

【特許補正5】

【特許補正6】

【特許補正7】

【特許補正8】

【特許補正9】

【特許補正10】

【特許補正11】

【特許補正12】

【特許補正13】

【特許補正14】

【特許補正15】

【特許補正16】

【特許補正17】

【特許補正18】

【特許補正19】

【特許補正20】

【特許補正21】

【特許補正22】

【特許補正23】

【特許補正24】

【特許補正25】

【特許補正26】

【特許補正27】

【特許補正28】

【特許補正29】

【特許補正30】

【特許補正31】

【特許補正32】

【特許補正33】

【特許補正34】

【特許補正35】

【特許補正36】

【特許補正37】

【特許補正38】

【特許補正39】

【特許補正40】

【特許補正41】

【特許補正42】

【特許補正43】

【特許補正44】

【特許補正45】

【特許補正46】

【特許補正47】

【特許補正48】

【特許補正49】

【特許補正50】

【特許補正51】

【特許補正52】

【特許補正53】

【特許補正54】

【特許補正55】

【特許補正56】

【特許補正57】

【特許補正58】

【特許補正1】

【特許補正2】

【特許補正3】

【特許補正4】

【特許補正5】

【特許補正6】

【特許補正7】

【特許補正8】

【特許補正9】

【特許補正10】

【特許補正11】

【特許補正12】

【特許補正13】

【特許補正14】

【特許補正15】

【特許補正16】

【特許補正17】

【特許補正18】

【特許補正19】

【特許補正20】

【特許補正21】

【特許補正22】

【特許補正23】

【特許補正24】

【特許補正25】

【特許補正26】

【特許補正27】

【特許補正28】

【特許補正29】

【特許補正30】

【特許補正31】

【特許補正32】

【特許補正33】

【特許補正34】

【特許補正35】

【特許補正36】

【特許補正37】

【特許補正38】

【特許補正39】

【特許補正40】

【特許補正41】

【特許補正42】

【特許補正43】

【特許補正44】

【特許補正45】

【特許補正46】

【特許補正47】

【特許補正48】

【特許補正49】

【特許補正50】

【特許補正51】

【特許補正52】

【特許補正53】

【特許補正54】

【特許補正55】

【特許補正56】

【特許補正57】

【特許補正58】

フロントページの続き

【特許補正1】

【特許補正2】

【特許補正3】

【特許補正4】

【特許補正5】

【特許補正6】

【特許補正7】

【特許補正8】

【特許補正9】

【特許補正10】

【特許補正11】

【特許補正12】

【特許補正13】

【特許補正14】

【特許補正15】

【特許補正16】

【特許補正17】

【特許補正18】

【特許補正19】

【特許補正20】

【特許補正21】

【特許補正22】

【特許補正23】

【特許補正24】

【特許補正25】

【特許補正26】

【特許補正27】

【特許補正28】

【特許補正1】

【特許補正2】

【特許補正3】

【特許補正4】

【特許補正5】

【特許補正6】

【特許補正7】

【特許補正8】

【特許補正9】

【特許補正10】

【特許補正11】

【特許補正12】

【特許補正13】

【特許補正14】

【特許補正15】

【特許補正16】

【特許補正17】

【特許補正18】

【特許補正19】

【特許補正20】

【特許補正21】

【特許補正22】

【特許補正23】

【特許補正24】

【特許補正25】

【特許補正26】

【特許補正27】

【特許補正28】

【特許補正1】

【特許補正2】

【特許補正3】

【特許補正4】

【特許補正5】

【特許補正6】

【特許補正7】

【特許補正8】

【特許補正9】

【特許補正10】

【特許補正11】

【特許補正12】

【特許補正13】

【特許補正14】

【特許補正15】

【特許補正16】

【特許補正17】

【特許補正18】

【特許補正19】

【特許補正20】

【特許補正21】

【特許補正22】

【特許補正23】

【特許補正24】

【特許補正25】

【特許補正26】

【特許補正27】

【特許補正28】